JP401108008

Publication Title:
No title available
Abstract:
Abstract not available for JP401108008
Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide
Courtesy of http://v3.espacenet.com

⑲ 日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-108008

(51) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)4月25日

B 28 D 5/00 H 01 L 21/78 Z - 7366 - 3CQ-8831-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

69発明の名称 半導体ウェハの切断方法

> ②特 願 昭62-266762

23出 願 昭62(1987)10月21日

⑫発 明 者 藤 本 博 昭

蜸

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

明 73発 者 竹

79発 明 者

造 浼 信

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

①出 願 人 松下軍器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

74代 理 人 弁理士 中尾 敏男

畑

⊞

橋

外1名

明 細

1、発明の名称

半導体ウェハの切断方法

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 複数枚の半導体ウェハを重ねて固定し、最上 部の半導体ウェハから最下部の半導体ウェハに 至る切断溝を形成することにより、前記複数枚 の半導体ウェハを同時に切断するようにした半 導体ウェハの切断方法。
 - (2) 複数枚の半導体ウェハを接着剤あるいは粘着 テープにより固定した特許請求の範囲第1項記 裁の半導体ウェハの切断方法。
- (3) 切断溝を砥石あるいはレーザーにより形成し た特許請求の範囲第2項記載の半導体ウェハの 切断方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体ウェハの切断方法に関するもの

うである。 従来の技術

従来の技術を第2図とともに説明する。従来の 技術としては、スクライブ法と、砥石によるダイ シング法があるが、ここではダイシング法につい て説明する。まず、第2図(a) に示すように、半導 体ウェハ21を粘着テープ22にはり付ける。そ の後、第2図(b)に示すようにダイシングソーによ り、切断溝23を形成し、最後に、第2図(c)に示 すように、粘着テープ22を引き伸ばし、半導体 チップ24を得るものである。

発明が解決しようとする問題点

前記従来例では、半導体ウェハを1枚づつしか 処理できず非常に長い時間を要するため、次に示 す問題点がある。

- (1) 特に大口径の半導体ウェハにおいては、拡散 工程、エッチング工程等他の工程との時間に関 するアンバランスが生じその結果、切断装置を 多数必要とする。
- (2) 上記の理由により非常にコストの高いものと なる。

本発明は、半導体ウェハの切断工程の生産性を

高め低コスト化を図るものである。

問題点を解決するための手段

本発明は、前記問題点を解決するために、半導体ウェハを複数枚重ねて同時に切断するものである。

作用

半導体ウェハを複数枚重ねて同時に切断すると とで、生産性を高め、低コスト化を図ることがで きる。

実施例

本発明の一実施例を第1図と共に説明する。

まず、第1図(a)に示すように、半導体ウェハ1を、粘着テープ2を用いて重ねて固定する。この時、各々の半導体ウェハ1の切断ラインは、一致させておく。半導体ウェハ1の位置合わせは、パターン認識を用いることにより、精度よく容易に実施できる。次に第1図(b)に示すように、ダイアモンド砥石あるいは、レーザーにより、最上部の半導体ウェハ1に至る、切断溝3を形成し、半導体チップ4を得る。

常にコストの安い、半導体を得ることができる。

4、図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例方法の工程別断面図、第2図は従来方法の工程断面図である。

1 ……半導体ウェハ、2 ……粘着テープ、3 ……切断溝、4 ……半導体チップ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

切断溝3の巾は10~50 µm 程度であり、切断 溝3の形成スピードは、50~200 mm/sec 程 度である。切断後の半導体チップ4の取り出しは、 最下部の粘着テープ2を引き伸ばし、半導体チッ プ4の間隔を広げた後、最上部の半導体ウェハ1 より切り出した半導体チップ4から使用する。粘 着テープ1の粘着力は非常に弱いため、真空コレ ット等で容易に半導体チップ4を取り出すことが できる。表面から2枚目および3枚目の半導体ウ ェハ1から切り出した半導体チップ4の表面に残 った粘着テープ2は、強い粘着力をもつ他の粘着 テープを粘着し、その後、180度ピーリングす ることにより、半導体チップ4上の粘着テープ2 は容易に除去することができる。本実施例では、 半導体ウェハの固定に粘着テープを用いたが、と れに限らず、接着剤やワックス等でもかまわない。

発明の効果

以上述べたように本発明では、複数枚の半導体 ウェハを同時に切断できるため、生産性が飛躍的 に向上し、大口径の半導体ウェハにおいても、非



